### LUMINESCENT ELEMENT AND IRIDIUM COMPLEX

Publication number: JP2002117978 (A)

Publication date: 2002-04-19

Inventor(s): IGARASHI TATSUYA; ISE TOSHIHIRO; MIYASHITA YOSUKE; FUJIMURA HIDETOSHI: OKADA HISASHI: MISHIMA MASAYUKI: KYU SETSUHO

Applicant(s): FULL PHOTO FILM COLTD

Classification:

. international:

H01L51/50; C07D213/61; C07F15/00; C09K11/06; H05B33/10; H05B33/14; H01L51/50; C07D213/00; C07F15/00; C09K11/06; H05B33/10; H05B33/14; (IFC1-

7); C07F15/00; H05B33/14; C07D213/61; C09K11/06; H05B33/10

- European:

Application number: JP20010189539 20010622

Priority number(s): JP20010189539 20010622; JP20000216338 20000717

### Abstract of JP 2002117978 (A)

when R2 is a fluorine atom.

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a luminescent element capable of emitting highluminance blue luminescence over a long period and having an excellent luminescence characteristic and provide an iridium complex allowing it. SOLUTION: This luminescent element has characteristics including the external quantum efficiency of 5% or above and the luminescence maximum wavelength &lambda max of 500 nm or below. At least one of the layers of the luminescent element having a luminescent layer or a plurality of organic compound layers including the luminescent layer between a pair of electrodes includes at least one of the compounds having the partial structure expressed by the general formula K-0, wherein, R1-R7 independently indicate a hydrogen atom or a substitutional group. R3 is not the hydrogen atom

Data supplied from the esp@cenet database --- Worldwide

## (19)日本図特許 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-117978 (P2002-117978A)

(43)公曜日 平成14年4月19日(2002.4.19)

FI	f-73-}*(参考)
H05	B 33/14 B 3 K 0 0 7
C 0 7 1	D 213/61 4 C 0 5 5
C 0 9 1	K II/06 660 4II050
H05	B 33/10
C 0 7 1	F 15/00 E
審查	前求 未請求 新求項の数11 OL (全 17 頁)
39(P2001-189539) (7i)出	要人 000005201 宮土写真フイルム株式会社
日 (2001, 6, 22)	神奈川県南足柄市中密210番地
	神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真
	フイルム株式会社内
(72)発	
	神奈川県南足柄市中昭210番地 富土写真
	フイルム株式会社内
(74)代	理人 100079049
	<b>弁理士 中島 淳 (外3名)</b>
	H 0 5 C 0 7 C 0 9 H 0 5 C 0 7 審查 39(P2001-189539) (71) 出 日 (2001. 6. 22) (72)発 38(P2000-216338) 日 (2000. 7. 17) (72)発

### 最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 発光案子及びイリジウム錯体

#### (57) 【嬰約】

【課题】 高輝度の青色発光を長時間発光可能な発光特 性に優れた発光器子およびそれを可能とするイリジウム 錯体を提供する。

【解決手段】 外部量子効率が5%以上で、且つ発光極 大飯長 l maxが500nm以下の特性を有する発光器 子である。また、一対の電極間に、発光層もしくは発光 脳を含む複数の有機化合物網を有する発光素子におい て、これらの綴の少なくとも一層に、下記一般式K-0 で表される部分構造を有する化合物を少なくとも一種含 むことを特徴とする発光素子である。一般式K-0中、 R ~R は各々独立に、水素原子または関換基を表す。 但し、R'がフッ潔原子の場合は、R'は水素原子である 工业组合区。

[(k)]

一般式K-0

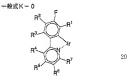
## [特許請求の範囲]

【請求項1】 外郷量子効率が5%以上で、且つ発光極 大波長2maxが500nm以下の特性を有することを 特徴とする発光素子。

【請求項2】 20でにおけるりん光量子収率が70% 以上で、且つりん光の発光標入波長月maxが500m 取以下である発光材料を含育することを特徴とする発光 募主。

【第水車3】 一対の電極際に、発光層もしくは兔光層 を食む機敗の有機化合物腸と有する発光素子において、 10 これらの棚の少なくとも一層に、下記一般式K-0で表 きれる部分構造を有する化合物を少なくとも一種含むこ とを特徴とする発光素子。

#### [4:1]



(一般式K ··· 0 中、R <sup>1</sup> ~ R <sup>7</sup> は各々独立に、水楽原子または龍機基を表す。但し、R <sup>2</sup> がフッ楽原子の場合は、 R (は水楽原子であることはない。)

【請求項4】 前記一般式K-0で表される部分構造を 有する化合物が、下記一般式K-1で表される部分構造 を有する化合物が、下記一般式K-1で表される部分構造 を有する化合物である請求項3に記載の発光素子。

## [/[:2]

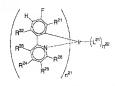


(一般式K-I中、R"~R"は各々独立に、水業原子 または機構基を表す。)

【請求項5】 下紀一般式KーIIで表されることを特徴 40 とするイリジウム錯体、

## [fb3]

#### 一般式K-||



(一般式K-II中、R" ~R" は各々独立に、水楽原子または置換基を表す。L" は直位子を表す。n" は1~3の整数を表し、n" は0~4の整数を表し、)

【額求項6】 前記一般式K-0で表される部分構造を 有する化台物が、下記一般式K-111で表される部分構造を有する化台物である錆束項3に記載の発光素子。

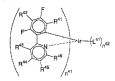
# 【化4】 - 般式K-III



(一般式K-III中、R<sup>\*\*</sup> ~R<sup>\*\*</sup> は各々独立に、水楽原 子または置換基を表す。)

【請求項7】 下記一般式K-IVで表されることを特徴とするイリジウム錯体。

#### 30 【化5】 一般式K-V



(一般式K-1V中、R" ~R"は各々絶立に、水素原 干または関換基を表す。L"は配位子を表す。n"は1 ~3の整数を表し、n"は0~4の整数を表す。

【請求項8】 前記一般式K-0で表される部分構造を 有する化合物、前記一般式K-1で表される部分構造を 有する化合物、前記一般式K-11で表されるイリジウム 錯体、前記一般式K-11で表される部分構造を有する 化合物、及び前記一般式K-1Vで表されるイリジウム 錯体の少なくとも一種を右有する請求項1に記載の発光

【詩來重9】 朝記20℃におけるり人光量子報率が7 0%以上で、且つりん光の養光療大波及入maxが50 0 nm以下である発光材料が、前記一般式K-0で表さ れる部分構造を有する化合物、前記一般式K-1で表さ れる部分構造を有する化合物、前記一般式K-IIで表さ れる中リジウム輸体、前記一般式K-IIで表される部 分構造を作する化合物、板が削記一般式K-IVで表さ れるイリジウム輸体の少なくとも一種である新来項2に 記載の発送業子。

【請求権10】 前監整光柱料を含有する層が、盤布プ 10 に着目してみると、DPVB i (4, 4' - ピス (2, ロセスで成接されている請求項2又は9に拡載の発光素 2 "・ジフェニルピニル) ーピマェニル)などに代表されるバスチリルアリーレン連維体方环をの部数体を用し

【請求項11】 前記一般式K-0で表される部分構造 を有する化合物を含有する層が、強布プロセスで成膜さ れている請求項3、4、6及び8のいずれかに記載の発 光素子。

## 【発明の詳細な説例】

## [0001]

【発明の廣する技術分野】本発明は、新規なイリジウム 排除およびこれを利用した発光素子に関し、特に詳細に 20 は、表示素子、ディスプレイ、パックライト、電子写 気、照明光源、記録光源、離光光源、総み取り光源、標 議、衛板、インテリア、光適信等の分野に好適に使用可 能な新規なイリジウム蟾体およびこれを利用した発光素 子に関する。

#### [00002]

【任来の技術】今日、種々の表示素子に関する研究開発 が后後であり、中でも再機電界発光(EL)素子は、低 電量で高騰度の発光を得ることができるため、有望な表 示索者として注目されている。例えば、有機化合物の蒸 30 着により有機連腰を形成する発光素子が知られている

(アプライド フィジックス レターズ, 51巻, 91 3頁, 1987年)。前記文献に記載の発光楽子は、ト 9ス(8--ヒドロキシキノリナト)アルミニウム錯体

1人 (4) を電子輸送材料として用い、窓望入職団・ (A) (4) を電子輸送材料として用い、窓望子輸送材料 を含有する層と、正孔輸送材料 (アミン化合物)を含有 する際とを模糊した構成であり、従来の単層型繋子と比 砂して発光特性を入標に向上させることが可能である。 近年、育機EL素子をカラーディスプレイおよび白色光 級へ適用することが活発に検討されている。有機EL素 40 子を網窓用途に供するには、青・線・赤の各々に発光可 能な発光素子それぞれについて、輝度および発光寿命等 の発光特性を向上させるが要がある。

[0003] ところで、発光特性が改善された発光素子 として、オルトメタル化イタジウム情体 (Ir(py)): Ir in the heutalated Complex of Iridium(II) with 2-Phenylpyridine)からの発光を利用した電光素子が優秀 されている(Applied Physicstatters, 75, (199 3).) 産業、発光素子はその発電量子機能について

は、5%が限界であるといわれていたが、前記文献に記 50

載の発光素十14.外部量子効率を%を達し、従来の限界を 超えるものである。しかし、前部発光素予から初られる 発光は、緑色発光に限られる為、ディスプレイとしての 適用範囲は狭い。他色についても発光特性が改善された 発光素子が使供できれば、ディスプレイとしての適用範 関も拡大されるので、他色の発光率子についても発光的 性の改善が現まれている。

#### [0004]

1発明が解決しようとする課例 ここで、育色発光楽子に着目してみると、DPVB:(4、4'ーピス(2,2'ージフェニルピニル)ーピフェニル)などに代表されるジスチリルアリーレン演練取及びその類線体を用いた発光素子等が多数報告されている。しかし、青色発光素子については、外部量子効率が多を超える漢子は未だ場合されていないのが実状である。黄色光光についても、外部量子効率が5%を増える発光素子が揺供できれば、高効率有機E1差子のカラー化、及び白色化が可能となり、用途拡大へ大き、前継さる。また、安宗素子に利用した場合に、発光の消費電力を大幅に「げることができるとともに、大面積化および長時間使用が可能となっ、用途は大へ大き、前継さる。また、

【0005】本発明は、前記諸問題に親みなされたものであって、発光時の消費エネルギーを軽減できるともに、高難度の青色発光を長時開発光可能な発光特性に優れた発光業子を提供することを課題とする。また、本発明は、長期間にわたって高難度の青色光を示す発光等性に優れたイリジウム錯体およびこれを利用した発光素子を提供することを課題とする。

#### [0006]

0 【課題を解決するための手段】 舶鉛課題を解決するための手段は以下の通りである。即ち、

<1> 外部量子効率が5%以上で、且つ発光極大波長 âmaxが500nm以下の特性を有することを特徴と する発光楽子である。

<2> 20℃におけるりん光量子収率が70%以上で、且つりん光の発光値大波展えma×が50りnm以下である発光材料を含有することを特徴とする発光素子である。

<3> 一好の電極間に、発光層もしくは発光層を含む 複数の有機化合物層を有する発光素子において、これら の層の少なくとも一層に、下記一般式K-0で表される 部分構造を有する化合物を少なくとも一種含むことを特 能少する落来源子である。

## [0007]

#### [K6]

【0008】 (一般式K-0中、R'~R'は各々独立 に、水素原子または籔巻基を表す。個し、R'がフッ素 原子の場合は、R'は水薬原子であることはない。)

<4> 前記一般式K-0で表される部分構造を有する 化合物が、下記一般式K-1で表される部分構造を有す る化合物である前記<3>に記載の発光素子である。 【0009】

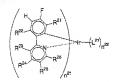
[@7]

【0010】(一般式K-I中、R"~R"は各々独立 に、水素原子または潜極系を変す。)

ぐ5> 下紀一般式Kー目で表されることを特徴とする イリジウム錯体である。

[0011]

[化8]



[0012] (一榖式K-II中、R<sup>2</sup> ~R<sup>2</sup> は各ヶ独立 に、水薬解子または質療基を要す。L<sup>2</sup> は配位子を表 す。n<sup>2</sup> は1~3の整数を表し、n<sup>2</sup> は0~4の整数を 表す。)

(6) 順記一級式民-0で表される部分構造を有する 化合物が、下記一級式民-11で表される部分構造を有 する化合物である前記<3>に記載の発光素子である。 [0013] 【作9]

【0014】 (一般式KーJIT中、R ~ ~ R ~ は各々独 10 立に、水楽原子または置換基を表す。)

< 7 > 下記一般式KーTVで表されることを特徴とするイリジウム雑体である。

[0015]

[化10] 一般式K-N

【0016】(一般式K-TV中、R ~ ~ R " は各々独立に、水楽原子または震樂基を表す。L"は配位子を表す。n"は1~3の整数を表し、n " は0~4の整数を表し、n だ 4 0~4の整数を表す。n " は 1~3の整数を表し、n が は 0~4の整数を表す。

<8> 前記一般式K-0で表される窓分構造を有する 0 化合物、削配一般式K-1で裏される部分構造を有する 化合物、削配一般式K-1で表されるインウム場体、 前記一般式K-11で表される部分構造を有する化合 物、及び前記一般式K-1Vで表されるイリジウム操作 の少なくとも一種を含有する前記<1>に記載の発光表 子である。

< 9> 前記20℃におけるりん光量子収申が70%以上で、且つりん光の発光極大波長3m×が500nm以下である発光材料が、創室一般式K・Iで表される部分構造を有する化合物、前窓一般式K・Iで表される部分構造を有する化合物、放び前途一般式K・IVで表されるイリジウム輸体、前記一般式K・IVで表される部分構造を有する化合物、及び前記一般式K・IVで表されるイリジウム輸体の少なくと・一様である前説べ2>に記載の発光等子である。

<10> 前記発光材料を含有する圏が、途布プロセス で成膜されている前記<2>または<9>のいずれかに 記載の発光素子である。

<11> 前記一般式K-0で表される部分構造を有する化合物を含有する層が、塗布プロセスで成膜されている
50 る前記<3>、<4>、<6>及び<8>のいずれかに

能動の発光素子である。

100171

【発明の実施の形態】本発明の発光素子は、外部量子効 準5%以上の高い発光効率で、発光極大波長 2 maxが 500 nm以下の青色発光を示すことを特徴とする。従 って、本業期の養光溶子は発光時の消費エネルギーを終 誠できるとともに、高輝度の青色発光を長時間発光可能 である。また、特に表示素子に利用した場合には、大面 領化が可能となる。尚、ここで、外部最子効率とは、以 効率の輸出方法としては、発光線度、発光スペクトル、 比視態度曲線および電流密度から築出する方法と、電流 密度および発光された全フォトン数から築出する方法と がある。

各部量子効率(%) == (発光された全フォトン数/発光 第子に注入された電子数) ×100

【0018】前記発光素子の外部量子効率は好ましくは 7%以上、より好ましくは10%以上である。また、本 発明の発光素子は、青色色純度の鍵点から、発光極大波 段 λ m a x が好ましくは390 n m以上495 n m以下 20 が発光する化合物であり、例としては、遷移金銭錯体 であり、より好ましくは400nm以上490nm以下 であり、更に好ましくは420nm以上480nm以下 てある。尚、本発明の発光業子は、発光極大波長が50 0 m以下にあれば青色領域以外の波長域、例えば、紫 外領域、緑色領域、赤色領域のいずれかにも発光を有し ていてもよい。

【0019】 前記発光素子は、発光色の青色色純度の観 点から、発光のCIE色度館のx 値およびy 値は小さい 程好主しい、具体的には 巻光のCIR色度値のx値は 0、22以下であるのが好ましく、0.20以下である 30 のがより好ましい。また、発光のC1E色度値のv値は 0.53以下であるのが好ましく、0.50以下である のがより好ましく、0、40以下であるのが更に好まし

【0020】 前記発光潔子は、青色色純度の観点から、 発光スペクトルの半鎖線が1 n m以上100 n m以下で あろのが好ましく、5 nm以上90 nm以下であるのが より好ましく、10nm以上80nm以下であるのがさ らに好まして、20nm以上70nm以下であるのが特 は好ましい。

【0021】前記発光案子は、システム、駆動方法、利 用影響など特に問わないが、その実施形態としてEL (エレクトロルミネッセンス) 案子を挙げることができ る、EL素子の一構成例としては、脳棒と陰極の一対の 電極間に、1以上の発光層を形成した発光素子が挙げら れる。その他、前記電極間に発光層の他、正孔注入層、 正引輸送艦、電子注入隊、電子輸送除および保護器のい ずれか1以上を有する発光薬子が挙げられる。またこれ もの各層が、それぞれ他の機能を備えたものであっても よい、各種の形成にはそれぞれ種々の材料を用いること 50

8 ができる。本発明の発光素子は、盲機発光素子であるこ とが好ましい。ここで、有機発光楽子とは、発光をつか さどる物質が有機化合物であるものを言う。 【0022】前記発光素子には、路様と発光層との間に

イオン化ポテンシャル5、9eV以上(より好ましくは 6. 0 e V以上7. 0 e V以下) の化合物を含有する層 を配置するのが好ましく、イオン化ポテンシャル5、9 e V以上の電子輸送層を配置するのがより好ましい。 【0023】前記発光素子には、発光材料として、りん 下の式により算出される値をいう。発光素子の外部量子 10 光量子収率の高い材料を用いるのが好ましい。具体的に は、20℃でのりん光量子収率が70%以上で、自つり ん光の発光振大波長 lmaxが500nm以下の発光材 料が好ましく、20℃でのりん光量子収率が80%以上 で、且つりん光の発光極大波長えmaxが490nm以 下の発光材料がより好ましく、20℃でのりん光量子段 率が85%以上、自つりん光の発光線大波長 lmaxが

> 【0024】前記発光材料とは、発光案子の発光層もし くは発光層を含む有機化合物層に含有されて、それ自身 (好ましくはオルトメタル化錯体) が好ましく、中で も、イリジウム錯体および白金錯体がより好ましく、オ ルトメタル化イリジウム錯体がさらに好ましく、後述す

る一般式K-0で表される部分構造を有する化合物が特

480 nm以下の発光材料がさらに好ましい。

に好ましい。 【0025】ここで、オルトメタル化錯体 (orthometal) ated Complexes) とは、例えば「有機金属化学-基礎と 応用-: p 1 5 0、2 3 2 紫華勝社 山本明宍嶺 1 9 8 2 年発行、「Photochemistry and Photophysics of C cordination Compounds; p71-p77, p135-p146 Springer -Verlag社 H. Yersin署1987年発行等に記載されてい る化合物群の総称である。

【0026】 前記発光素子は、下記一般式ドー0で表さ れる部分構造を有する化台物(以下、「イリジウム化合 物:という場合がある)を発光材料として含有するのが 好ましく、前記イリジウム化合物の中でも、りん光量子 収率およびりん光の発光極大波長Amaxか前述の範囲 である化合物を含有するのが好ましい。以下、下能一般 式K-0に関して詳細に説明する。なお、本発明におけ 40 る発光材料は、変光素子の発光層もしくは発光層を含む 複数の右機化合物層に含有されることで機能する。

[0027] [化11]

【0028】R'~R'は各々独立に、水楽原子または微 換基を載す。但し、R がフッ素原子の場合は、R は水 10 い。 溶原子であることはない。 鬱塵基としては、後述の一般 式K-1におけるR"で説明する基が挙げられる、R' は好ましくは水楽原子、アルキル基、アリール基、ヘテ ロアリール基であり、より好ましくは水素原子である。 R は水薬原子、アルキル基、アリール基、ヘテロアリ …ル基、フッ素原子であり、より好ましくは水密原子。 フッ素原子、アルキル基である。R は好ましくは水素 原子、アルキル基、アリール基、ヘテロアリール基、フ ッ素原子であり、より好ましくは水素原子、フッ素原子 であり、更に好ましくはフッ素原子である。

【0029】R\*は好ましくは水素原子、アルキル基。 置換または無置機のアミノ基、アルコキシ基であり、よ り好ましくは水素原子、アルキル基、アルコキシ基であ り、更に好ましくは水素原子である。R'. R'及びR' は好ましくは水素原子、アルキル基であり、より好まし くは水素菓子である。

【0030】前記イリジウム化合物におけるイリジウム 原子の領数は、特に限定されるものではないが、3億が 好ましい。また、箱紀イリジウム化合物は、イリジウム 原子を1つ含むいわゆる単級錯体であってもよいし、ま 30 た2つ以上含むいわゆる複核錯体であってもよい。中で 5. イリジウム原子を1つ含む風接錯体が好ましい。ま た、前記イリジウム化合物は、イリジウム以外の他の金 展原子を含んでいてもよいが、中心金銭がイリジウムの みである化合物が好ましい。

【0031】前記イリジウム化合物は、構造中に種々の 配位子を有することができる。前距配位子としては、例 APJ. Photochemistry and Photophysics of Coordin ation Compounds) Springer-Verlag計, H. Yersin署 1 以87年発行、「有機金銭化学-- 基礎と応用-- | 業績 40 房社 山本明夫著 1982年発行 第に記載の配位子が 挙げられる。前記配位子としては、単座配位子であって も、2座配位子等の多座配位子であってもよい。前記配 位学としては、ハロゲン配位子(好ましくは塩素配位 子)、含窒素ヘテロ機配位子(例えばフェニルピリジ ン、ベンゾキノリン、キノリノール、ビビリジル、フェ ナントロリンなど)、ジケトン配位子、カルボン酸配位 子、PF。配位子が好ましく、ジケトン配位子(アセチ ルプセトン等) がより好ましい。前能イリジウム化合物 に含まれる配位子は、1種類でもよいし、2種類以上で 50 アルキル基(好ましくは炭素数1~30、より好ましく

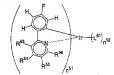
あってもよい。前記イリジウム化台物中の紀位子の種類 は、好ましくは1および2種類であり、特に好ましくは 1種類である。また、前記イリジウム化合物は、電荷を 有さない中性錯体でもよいし、対塩(例えば塩素イオ ン、PF。イオン、CIO(イオン)を有するイオン性錯 体であってもよい。中でも、中件錯体が好ました。

【0032】前記イリジウム化合物に含まれる炭素数は 15~100であるのが好ましく、20~70であるの がより好ましく、30~60であるのがさらに好まし

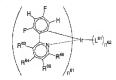
【0033】一般式K-Dで表される部分構造を有する 化合物の好ましい形態は、一般式K-1で表される部分 構造を有する化合物、または、一般式K-111で表され る部分構造を有する化合物であり、より好ましい形態 は、一般式K-IIIで表される部分構造を有する化合物 である。一般式K-1で表される部分構造を有する化合 物は、より好ましくは一般式K-11で表されるイリジウ ム錯体であり、より好ましくは一般式K-Vで表される イリジウム錯体である。一般式KーIIIで表される部分 20 構造を有する化合物は、より好ましくは一般式K-IV で表されるイリジウム錯体であり、より好ましくは一般 式KーVIで表されるイリジウム循体である。

[0034]

[作12] 一般式K-V



[0035] [1213] --粉計K-V



【0036】次に、一般式K-1について説明する。前 記一般式K-I中、R"およびR"は各々独立して、水 素原子または罷検基を表す。離接基としては、例えば、

は炭素数1~20、特に好ましくは炭素数1~10であ り、例えばメチル、エチル、isoープロピル、ter i ープテル、nーオクテル、nーデシル、nーヘキサデ シル、シクロプロビル、シクロペンチル、シクロヘキシ ルなどが挙げられる。)、アルケニル基(好ましくは炭 素飲2~30、より好ましくは炭素数2~20. 特に好 ましくは現案数2~10であり、例えばビニル、アリ ル、2 - ブテニル、3 - ベンテニルなどが挙げられ る。)、アルキニル基(好ましくは炭素数2~30、よ り好ましくは炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2 ~10であり、例えばプロバルギル、3~ペンチニルな どが挙げられる。)、

【0037】アリール基(好ましくは炭素数6~30、 より好ましくは炭素数6~20、特に好ましくは炭素数 6~12であり、例えばフェニル、p -- メチルフェニ ル、ナフチル、アントラニルなどが挙げられる。)、ア ミノ稿(好ましくは炭素数0~30、より好ましくは炭 業数0~20、特に好ましくは炭素数0~10であり、 例えばアミノ、メチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチ ルアミノ、ジベンジルアミノ、ジフェニルアミノ、ジト 20 バモイル、メチルカルバモイル、ジエチルカルバモイ リルアミノなどが挙げられる。)、アルコキシ基(好ま しくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~2 の、特に好ましくは淡素数1~10であり、例えばメト やシ、エトキシ、プトキシ、2-エチルヘキシロキシな どか挙げられる。)、アリールオキシ基(好ましくは炭 素数6~30、より好ましくは炭素数6~20、特に好 ましくは炭素数6~12であり、例えばフェニルオキ シ、1…ナフチルオキシ、2…ナフチルオキシなどが挙 げられる。)、ヘテロアリールオキシ基(好ましくは炭 素数1~30、より好ましくは炭素数1~20、特に好 30 ましくは炭素数1~12であり、例えばビリジルオキ >、ビラジルオキシ、ビリミジルオキシ、キノリルオキ ンなどが挙げられる。)、

【0038】アシル基(好ましくは炭素数1~30、よ り好ましくは炭素数!~20、特に好ましくは炭素数1 ~12であり、例えばアセチル、ベンゾイル、ホルミ ル、ビバロイルなどが挙げられる。)、アルコキシカル ポニル基(好ましくは炭素数2~30、より好ましくは 炭素数2~20 特に好ましては影楽数2~12であ どが挙げられる。)、アリールオキシカルボニル基(好 ましくは炭素数7~30、より好ましくは炭素数7~2 り、特に好ましくは炭素数7~12であり、例えばフェ ニルオキシカルボニルなどが挙げられる。)、アシルオ キン帳(好ましくは炭素数2~30、より好ましくは炭 素数2~20、特に好主しくは炭素数2~10であり、 側えばアセトキシ、ベンゾイルオキシなどが挙げられ る。)、アシルアミノ磊(好ましくは炭素数2~30、 より好ましくは炭素数2~20、物に好ましくは炭素数

ミノなどが挙げられる。)、 【0039】アルコキシカルボニルアミノ基(好まして は炭素数2~30、より好ましくは炭素数2~20、特 に好ましくは炭素数2~12であり、例えばメトキシカ ルポニルアミノなどが挙げられる。)、アリールオキシ カルボニルアミノ基(好生しくは炭素数7~30、より 好ましくは炭素数7~20、特に好ましくは炭素数7~ 12であり、例えばフェニルオキシカルボニルアミノな どが挙げられる。)、スルホニルアミノ基(昇ましくは 10 炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~20、特に 好ましくは炭素数1~12であり、例えばメクンスルホ ニルアミノ、ベンゼンスルホニルアミノなどが挙げられ る。)、スルファモイル基(好ましくは磁器数0~3 0、より好ましくは炭素数0~20、特に好ましくは炭 素数0~12であり、例えばスルファモイル、メチルフ ルファモイル、ジメチルスルファモイル、フェニルスル ファモイルなどが挙げられる。)、カルバモイル蒸(好 ましくは映楽数1~30、より好ましくは映楽数1~2 0、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばカル ル、フェニルカルバモイルなどが挙げられる。)、アル キルチオ基(好ましくは炭素数1~30、より好ましく は炭素数1~20、特に好ましくは炭素数1~12であ り、例えばメチルチオ、エチルチオなどが挙げられ る.)、アリールチオ基(好ましくは炭素数6~30、 より好ましくは炭素数6~20、特に好ましくは炭素数 6~12であり、例えばフェニルチオなどが発げられ る。)、

【0040】 ヘテロアリールチオ基(好ましくは影響数 1~30、より好ましくは炭素数1~20、特に好まし くは炭素数1~12であり、例えばピリジルチオ、2~ ベンズイミゾリルチオ、2 ーバンブオキサゾリルチオ、 2-ペンズチアゾリルチオなどが挙げられる。)、スル ホニル基 (好ましくは漿素数1~30、より好ましくは 原素数1~20、特に好ましくは炭素数1~!2であ り、何えばメシル、トシルなどが幾げられる。)、スル フィニル基 (好ましくは検案数1~30、より好ましく は模素数1~20、特に好ましくは模素数1~12であ り、例えばメタンスルフィエル、ベンゼンスルフィエル り、例えばメトキシカルボニル、エトキシカルボニルな 40 などが挙げられる。)、ウレイド基(好ましくは炭素数 1~30、より好ましくは廃素数1~20、特に好まし くは炭素数1~12であり、例えばウレイド、メチルウ レイド、フェニルウレイドなどが挙げられる。)、リン 酸アミド基(好ましくは炭素数1~30、より好ましく は炭素数 : ~ 20、特に好ましくは炭素数 : ~ 12であ り、例えばジエチルリン酸アミド、フェニルリン酸アミ トなどが挙げられる。)。

【0041】ヒドロキシ基、メルカプト基、ハロゲン原 子(例えばフッ楽原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原 は~10であり、例えばアセチルアミノ、ベンゾイルア 50 子)、シアノ基、スルホ基、カルボキシル基、ニトロ

(8)

14

基、ヒドロキサム酸基、スルフィノ基、ヒドラジノ基、 イミノ基、ヘテロ環基(原的販売・戸口環基、ヘテロアリール店が解けられ、辞ましくは業数1~32であり、ヘテロ原子としては、倒えば高素原子、酸薬原子、酸薬原子、最体のたらは付え (型イミダソリル、ビリジル、キノリル、フリル、オールインリンル、モルボリジル、セルング、カールバリシル、ベンズオキサブリル、ベンズイミダソリル、ベンズイミダンリル、ベンズイミダンリル、ベンズオキサブリルな 生が挙げられる。)、シリル器(好ましくは決実数3~ 40、より付ましくは決業数3~30、特に好ましくは決実数3~ 40、より付ましくは決業数3~30、特に好ましくだか。 デエニルシリルなどが挙げられる。などが挙げられる。これもの健康主は実に常強をおれていませ、

【0042】前記一般式K-1中、R<sup>\*</sup> は水薬原子、ア ルキル基、アリール基またはペテロアリール基であるの が針ましく、水薬原子であるのがより針ましい。前記一 修式K-1中、R<sup>\*</sup> は水薬原子、アルキル基、アリール 基、ペテロアリール基またはフッ薬原子であるのが好ま しく、水薬原子またはフッ薬原子であるのがより好まし く、フッ薬原子であるのがさらに好ましい。

[0043] 前記一般式长-I中、R<sup>n</sup> へR<sup>n</sup> は各々独 たに、本郷原子または散集基を表す。散集基が結合して 原標度を形成してもよい。 間樂基としては前配R<sup>n</sup> の基 が挙げられる。 前記一般式K-I中、R<sup>n</sup> は木素原子、 アルキル 原、 配換もしくは樂間後のアミノ源、またはア ルコキシ基であるのが好まし、木業原子、ルルキル 基、またはアルコキシ基であるのがより好ましく、木素 原子であるのが特に好ましい。 前記一般式K-I中、R であるのが好ましく、水素原子また「アルキル基 であるのが好ましく、水素原子また「アルキル基 であるのが好ましく、水素原子また「アルキル基

[0044] 次に、一般式R-Hについて説明する。一 粉式K-H中、R"、R"、R"、R"、R" 及びR" は、それぞれ時記一般式K-1におけるR"、R"、R "、R"、R"及びR"と同義であり、好ましい範囲も 間じである。

【9045】一般式KーII中、L" は配位子を表し、配位子としては、例えば、「Photochreistry and Photophy spice of Coordination Compounds」 Springer-Verlag 注 B.Yarsin著 1987年第行。「有機金属化学-基礎 40上以用…」 業華房社 山本朔夫著 1982年発行 等に 記載の配位庁が銀げられ、例ましくは、ハロウン配位庁 (何ましくは金廉配位子)、含意案ペラロ環配位子 (何ましくは金廉配位子)、含意案ペラロ環配位子 (何ましくは全原配位子)、カリンール、ビビリジル、フェナントロリンなど)、ジクトン配位子、カルボン機配位子であり、より好ましくは含密案ペラロ機配行・ジケトン配位子である。

【0046】n"は1~3の整数を表し、より好ましく は1または2である。n"は0~4の整数を表し、より 好ましくは0または1である。 【0047】次に、一般式K一川について前別する。一般式K一川中、R" およびR"は各々独立に、木楽原子または置換基を表す。置換基としては情影一般式K 一」におけるR"の基が挙げられる。R"は対まして、水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロアリール基であり、より好ましくは水素原子である。R"は対ましくは水素原子で、アルキル基、アリール系、ヘテロアリール基、フッ素原子であり。より好ましくは水薬原子で、フッ素原子であり、さらに好ましくは水薬原子である。

[0048] 一般式K-III中、R"~R" は各々独立。

に、水楽原子または鬱維基を寄す。鬱維基が結合して繋 構造を形成してもよい。置換基としては前部一般式K-1におけるR"の基が挙げられる。R"は好ましくは水 素原子、アルキル基、置換もしくは無置換のアミノ基、 アルコキシ基であり、より好ましくは水素原子、アルキ ル基、アルコキシ基であり、更に好ましくは水素原子で ある。R"、R" およびR" は、好ましくは水素原子、 アルキル基であり、より好ましくは水溶照子である。 【0049】次に、一般式K-IVについて説明する。 一般式K-IV中、R"、R"、R"、R"、R" およ びR\*は、それぞれ前記一般式K-IIIにおけるR\*。 R", R", R", R" およびR" と開義であり、好ま しい範囲も同じである。L" は前記一般式K-TIにおけ るし"と開業であり、好ましい範囲も間じである。 n° は1~3の整数を表し、好ましくは1または2である。 n は0~4の整数を表し、0または1が好ましい。 【0050】次に、一般式K-Vについて説明する。--般式K-V中、R°、R°、R°、R°、L°、n° お よびn"は、それぞれ前記一般式K-11におけるR"、 30 R"、R"、R"、L"、n"およびn" と回義であ

【0051】次に、一般式K-VIについて説明する。 一般式K-VI中、R<sup>n</sup>、R<sup>n</sup>、R<sup>n</sup>、R<sup>n</sup>、L<sup>n</sup>、n "およびn"は、それぞれ申訟一般式K-IVにおける R<sup>n</sup>、R<sup>n</sup>、R<sup>n</sup>、R<sup>n</sup>、L<sup>n</sup>、n およびn"と阅義 であり、好ましい範囲も同じである。

り、好ましい範囲も同じである。

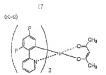
【0052】 前、前記イリジウム化令物は、いわゆる低分子化合物であっても、また前記一般式水一ので表される部分構造を有する繰り返し単位を含む、いわゆるオリコマー化合物料はがポリマー化合物(質量平均分子量(ボリスチレン検算)付好ましくは1000~5000 00、より好ましくは2006~100000。 56に好ましくは300~10000である。)であってもよい。中でも、前記イリジウム化合物は低分子化今物であるの好ままい。

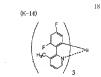
【0053】以下に、前紀一般式K-0で実される部分 構造を有するイリジウム化合物の化合物例(K-1~K -25)を示すが、本発明はこれらに限定されるもので はない。

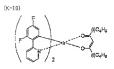
50 [0054]

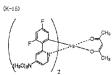


[0055]



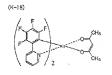












[0056]

[化16]

【0057】前紀一般式K-0で表される部分構造を有 する化台物は、種々の手法で合成することができる。例 えば、種々の配位子またはその解離体とイリジウム化合 物とを、溶媒(例えば、ハロゲン系溶媒、アルコール系 溶媒、エーテル系溶媒、水などが挙げられる)の存在ド もしくは溶媒非存在下、塩基の存在下(無機、有機の種 々の塩基、例えば、ナトリウムメトキサイド、1ープト キシカリウム、トリエチルアミン、炭酸カリウムなどが 挙げられる)もしくは塩基非存在下、室園以下もしくは 型熱して(通常の加熱以外にもマイクロウェーブで加熱 50 途、蛍光増白剤、写真用材料、UV吸収材料、レーザー

20 (K-24) (K-25)

> する手法も有効である)、合成することができる。出発 原料としては、例えば、イリジウムクロライド(11 I) 、トリスアセチルアセトナトイリジウム(III)、ボ タシウムヘキサクロロイリデート (III) 、ボタンウム ヘキサクロロイリデート (IV) 及びその類縁体を用いる ことができる。

【0058】尚、前記一般式K一目で表されるイリンウ ム錯体および前距一般式K-TVで表されるイリジウム 錯体は、発光素子の材料として利用できる他 医療用

色素、カラーフィルター用染料、色変換フィルター等に も使用可能である。

[0059] 本発明の発光素子の別の形飾は、脇極およ び陰極からなる一対の端極間に、発光層もしくは発光層 を向む複数の有機化合物服を有する発光器子において、 これらの層の少なくとも一層に、前紀イリジウム化合物 の少なくとも1額を含む発光素子である。前配イリジウ ム化合物は、新効率で省色発光する特性を有するので、 発光層に含有させることによって、発光素子の発光効率 を向上させることができる。また、前記イリジウム化合 10 物は、良好な電荷輸送性能を有するので、電荷輸送層に 含有させた場合も、発光案子の発光効率を向上させるこ とができる。その結果、発光時の消費エネルギーを軽減 できるとともに、高輝度の青色発光を長時開発光可能な 発光素子を提供することができる。

【0060】前記発光素子は、前記電極間に発光層の 他、正孔注人層、正孔輸送陽、電子注入層、電子輸送層 および保護層などを有してもよく、またこれらの名層は それぞれ他の機能を備えたものであってもよい。前記発 光素子には、陰極と発光層との間にイオン化ポテンシャ 20 が、通常10nm~5μmの範囲のものが好ましく、よ ルS. 9eV以上(より好ましくは6, 0eV以上7, ○ 6 V以下)の化合物を含有する層を配置するのが好ま しく、イオン化ポテンシャル5、9eV以上の電子輸送 層を配置するのがより好ましい。各層の形成にはそれぞ れ種々の材料を用いることができる。前記発光器子にお いて、前記イリジウム化合物は、発光層に発光材料とし 工食有させることができるのはもちろん、電荷輸送層に 舎有させることもできる。

【0061】前記イリジウム化合物を含有する脳の形成 方法としては、特に限定されるものではないが、真空蒸 30 い。基板の厚みは、機械的強度を保つのに十分であれば 著法、LB法、抵抗加熱蒸着法、電子ピーム法、スパッ タリング法、分子積層法、コーティング法 (スピンコー 上法、キャスト法、ディップコート法など)、インクジ エット法、印刷法などの種々の方法を利用することがで き、特性面、製造面で抵抗加熱蒸着、コーティング法が 好ましい。特にコーティング法は、ディスプレイ用途等 の大面積化が必要な用途に供する場合に、製造コストが 軽減できる点で有利である。

【0062】前記コーティング法では、前記イリジウム 化含物を溶媒に溶解して強布液を調製し、該逾布液を所 40 望の層(あるいは電極)上に、塗布・乾燥することによ って形成することができる。塗布液中には樹脂を含有さ せてもよく、樹脂は檸媒に溶解状態とすることも、分散 状態とすることもできる。前記樹脂としては、非共役系 高分子(例えば、ボリビニルカルパゾール)および共役 差高分子 (例えば、ボリオレフィン系高分子) を使用す ることができる。より具体的には、例えば、ボリ塩化ビ ニル、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリメチルメ タクリレート、ポリプチルメタクリレート、ポリエステ 中、ポリスルホン、ポリフェニレンオキシド、ポリブタ 50

ジエン、ボリ (N-ビニルカルパゾール)、炭化水素槽

脂、ケトン樹脂、フェノキシ樹脂、ポリアミド、エチル セルロース、酢酸ビニル、ABS樹脂、ポリウレタン、 メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹 脂、エポキシ樹脂、シリコン樹脂などが挙げられる。 【0063】前院陽極は正孔注入層、正孔輸送層、発光

層などに正孔を供給するものであり、金属、合金、金属 酸化物、鬱気伝導性化合物、またはこれらの混合物など を用いることができ、好ましくは仕事関数が4eV以上 の材料である。具体例としては酸化スズ、酸化亜鉛、酸 化インジウム、酸化インジウムスズ(ITO)等の異常 性金属酸化物、あるいは金、銀、クロム、ニッケル等の 金鷹。さらにこれらの金属と運輸性金属酸化物との混合 物または積層物、ヨウ化鋼、硫化網などの無機準電性物 質、ボリアニリン、ボリチオフェン、ボリビロールなど の有機導電性材料、およびこれらと1 T O との額層物な どが挙げられ、好ましくは、導篙性金銭酸化物であり、 特に、生産性、高導電性、透明性等の点からITOが好 ましい。陽極の際原は材料により適宜選択可能である り好ましくは50nm~lumであり、更に好ましくは 100nm~500nmである。

【0064】前記職権は通常、ソータライムガラス、無 アルカリガラス、透明樹脂基板などの上に勝形成したも のが用いられる。前記透明基板としてガラスを用いる場 合、その材質については、ガラスからの溶出イオンを少 なくするため、無アルカリガラスを用いることが好まし い。また、ソーダライムガラスを用いる場合、シリカな どのバリアコートを施したものを使用することが好まし 特に制限はないが、ガラスを用いる場合には、通常 0. 2mm以上、好ましくは0.7mm以上のものを用い

【0065】 前記器極の作製には材料によって種々の方 法が用いられるが、例えば1T〇の場合、電子ビーム 法、スパッタリング注、抵抗加熱蒸激法、化学反応法 (ソルーゲル法など)、酸化インジウムスズの分級物の 盤布などの方法で膜形成される。陽極に洗浄またはその 他の処理を施すことにより、装光素子の駆動器圧を下げ たり、発光効率を高めることができる。例えばITOの 場合、UV-オゾン処理、プラスマ処理などが効果的で ある。

【0066】前記路極は電子往入層、電子輸送器、発光 層などに電子を供給するものであり、電子注入層、電子 輸送層、発光層などの負極と隣接する層との密管性やイ オン化ポテンシャル、安定性等を考慮して選ばれる。除 極の材料としては金属、合金、金属ハロゲン化物、金属 酸化物、電気伝導性化合物、またはこれらの混合物を用 いることができ、具体例としてはアルカリ金属(例えば しi、Na、K等) 及びそのフッ化物または微化物。ア

(13)

ルカリ主覇金属 (例えばMg. Ca等) 及びそのフッ化 物または酸化物、金、銀、鉛、アルミニウム、ナトリウ ムーカリウム合金またはそれらの混合金属、リチウムー アルミニウム合金またはそれらの混合金属、マグネシウ ムー銀合金またはそれらの混合金属、インジウム、イッ テリビウム等の希土類金属等が挙げられる。好ましくは 仕事関数が4eV以下の材料であり、より好ましくはア ルミニウム、リチウムーアルミニウム合金またはそれら の混合金属、マグネシウムー銀合金またはそれらの混合 金属等である。前記陰極は、上記化合物及び混合物の単 10 層構造であってもよいし、上記化合物及び混合物を含む 積蓄構造であってもよい。例えば、アルミニウム/フッ 化リチウム、アルミニウム/酸化リチウム の緒際構造 が好ましい。酸極の膜壁は材料により適宜選択可能であ るが、通常10nm~5μmの範囲のものが好ましく、 より好ましくは50 nm~1 umであり、更に好ましく #100 nm~1 um c 53.

【0067】前記陰極の作製には電子ビーム法、スパッ タリング法、抵抗加熱蒸着法、コーティング法などの方 法が用いられ、金羅を単体で務着することも、二成分以 20 上を同時に蒸煮することもできる。さらに、複数の金属 を同時に蒸着して含金電極を形成することも可能であ り、またあらかじめ調製した合金を蒸着させてもよい。 高、前犯陽極及び前訟除極のシート抵抗は低い方が好主

しく、数百Ω/□以下であるのが好ましい。 【0068】前記発光層の材料は、電界印加時に陽極ま たは正孔注人層、正孔輸送層から正孔を注入することが できると共に陰極または電子注入層、電子輸送層から電 子を注入することができる機能や、注入された僧器を移 させる機能を有する脚を形成できるものであればいずれ でもよい。前記発光層は、前記イリジウム化合物を発光 材料として含有すると、高効率での青色発光が可能とな るので好ましい。但し、前記イリジウム化合物が発光層 以外の有機化合物層に含有される場合は、他の発光材料 を用いることができる。前記他の豪光材料としては、例 えば、ベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミダゾール 誘導体、ベンゾチアゾール誘導体、スチリルベンゼン誘 響体、ボリフェニル誘導体、ジフェニルプタジエン誘導 体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ナフタルイミド 40 誘導体 クマリン誘導体、パリレン誘導体、ペリノン誘 - 葬体、オキサジアプール誘導体、アルダジン誘導体、ビ ラリジン誘導体、シクロペンタジェン誘導体、ビススチ リルアントラセン誘導体、キナクリドン誘導体、ビロロ ピリジン誘導体、チアジアプロピリジン誘導体、シクロ ペンタジエン誘導体、スチリルアミン誘導体、芳香族ジ メチリディン化合物、8-キノリノール誘着体の金属錯 体や希上類錯体に代表される各種金属錯体等、ボリチオ 2エン、ボリフェニレン、ボリフェニレンビニレン等の

光層には、前記イリジウム化合物とともに、前記他の挙 光材料のいずれかを併用してもよい。 【0069】前記発光層には簡記イリジウム化合物とと もに、前記イリジウム化合物をゲスト材料とするホスト

材料を含有させてもよい。前記ホスト材料としては、例 えば、カルパゾール骨格を有するもの、ジアリールアミ ン骨格を有するもの、ピリジン骨格を有するもの、ビラ ジン骨格を有するもの、トリアジン骨格を有するものお よびアリールシラン骨格を有するもの導か挙げられる。 前記ホスト材料のT」(最低三重項励超状態のエネルギ ーレベル)は、ゲスト材料のT: レヘルより大きいこと が好ましい。前記ホスト材料は低分子化合物であって も、高分子化合物であってもよい。前記ホスト材料と前 記イリジウム化合物等の発光材料とを共蒸着等すること によって、前紀発光材料が前記ホスト材料にドープされ た発光層を形成することができる。

【0070】前記発光艇の膜輝は特に眼定されるもので はないが、通常、1nm~5µmであるのが好ましく。 5 nm~1 umであるのがより好ましく、10 nm~5 00nmであるのが更に好ましい。

【0071】前記発光圀の形成方法は、特に限定される ものではないが、抵抗加熱蒸着、電子ビーム、スパッタ リング、分子積層法、コーティング法(スピンコート 法、キャスト法、ディップコート法など)、インクジェ ット法、印刷法、LB法などの方法が用いられ、好まし くは抵抗加熱蒸着、コーティング法である。

【0072】前記正孔注人履および前記正孔輸送履の材 料としては、陽様から正孔を注入する機能、正孔を輸送 する機能、陰極から注入された電子を朦朧する機能のい 動させろ機能、正孔と電子の再結合の場を提供して発光 30 ずれか有しているものであればよい。その具体例として は、カルパゾール誘導体、トリアゾール誘導体、オキサ ゾール誘導体、オキサジアゾール誘激体、イミダゾール 誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導 体、ビラゾロン誘潮体、フェニレンジアミン誘導体、ア リールアミン誘導体、アミノ機構カルコン誘導体、スチ リルアントラセン誘導体 フルオレノン誘導体 ヒトラ ゾン誘導体、スチルベン誘導体、シラザン誘導体、背巻 族第三級アミン化合物、スチリルアミン化合物、芳香族 ジメチリディン系化合物、ボルフィリン系化合物、ボリ シラン系化合物、ボリ (N-ビニルカルバゾール) 誘導 体、アニリン系共重合体、チオフェンオリゴーマー、ポリ チオフェン等の導電性高分子オリゴマー、有機シラン誘 藤体、前距イリジウム化合物等が挙げられる。前距正孔 注入層および前記正孔輸送層の機解としては、特に限定 されるものではないが、通常1mm~5μmであるのが 好ましく、5 n m~1 u m であるのがより好意しく、1 0 nm~500 nmであるのが更に好ましい。また、前 記正孔注入層および前記正孔輸送欄は上述した材料の1 種または2種以上からなる単脳構造であってもよいし、 ボリベー化合物、有機シラン誘導体等が挙げられる。発 50 間一組成または異種組成の複数層からなる多層構造であ

(14)

ってもよい。前記正孔注入形および前記正孔輸送層の形 成方法には、前記イリジウム化合物を含有する層の形成 方法で例示したのと同様の方法が利用できる。

【0073】 前記継子注入巖および前記鑑予輸送器の材 料は、陰極から電子を注入する機能、電子を輸送する機 無、路線から対人された正孔を適勝する機能のいずれか 有しているものであればよい。その具体例としては、ト リアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾ 一ル誘導体、イミダゾール誘導体、フルオレノン誘導 体、アントラキノジメタン誘導体、アントロン誘導体、 ジフェニルキノン議機体、チオピランジオキシド議構 体、カルボジイミド誘導体、フルオレニリデンメタン誘 導体、ジスチリルビラジン誘導体、ナフタレン、ベリレ ン等の告香環テトラカルボン酸無水物。フタロシアニン 誘導体、8-キノリノール誘導体の金属錯体やメタルフ タロシアニン ベンゾオキサゾールやベンゾチアゾール を配位子とする金麗錯体に代表される各種金麗錯体、有 摄しラン誘導体、および前記イリジウム化合物等が挙げ られる。前記電子注入層および前記電子輸送層の隙厚は あるのが好ましく、5 nm~1 umであるのがより好ま しく、10nm~500nmであるのが更に好ましい。 前記電子注入層および前記電子輸送層は上述した材料の 1 揺または2種以上からなる単層構造であってもよい し、同一組成または異種組成の複数層からなる多層構造 であってもよい。また、前紀電子注入層および前記電子 輸送層の形成方法としては、前記イリジウム化合物を含 有する際の形成方法で例示したのと間様の方法が利用で 赤 為。

の素子的化を促進するものが業子内に入ることを抑止す る機能を有しているものであればよい。その具体例とし Tit, In, Sn. Pb. Au, Cu. Ag, Al, T 1、Ni等の企業、MgO、SiO、SiO:、Al:O 1, GeO, NiO, CaO, BaO, FerOr, YrO :、TiO。等の金属酸化物、SiN。、SiN。O。等の 企議覧化物、MgFi、LiF、AlFi、CaFs等の \*

\* 合属フッ化物、ボリエチレン、ボリプロビレン、ボリメ チルメタクリレート、ポリイミド、ポリウレア、ポリテ トラフルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレ ン ポリジクロロジフルオロエチレン クロロトリフル オロエチレンとジクロロジフルオロエチレンとの共重合 体 テトラフルオロエチシンと少なくとも 1 種のコモノ マーとを含むモノマー混合物を共電合させて得られる共 重合体、共重合主類に環状構造を有する含フッ素共重合 体、吸水率1%以上の吸水性物質、吸水率0、1%以下 10 の防湿性物質等が挙げられる。前記保護層の形成方法に ついても特に限定はなく、前記イリジウム化合物を含有 する脳の形成方法で例示したのと同様の方法が利用でき る..

【0075】本発明の発光素子は、表示繁子、ディスプ レイ、バックライト、電子写真、照明光源、記録光源、 露光光源、読み取り光源、標識、看板、インテリア、光 通信等の広い分野の用途に供することができる。 [0076]

【実施例】以下に、本発明の実施例を説明するが、本発 特に限定されるものではないが、通常 1 n m ~ 5 g mで 20 明は以下の実施例になんら限定されるものではない。 「合成例1]

(化合物例K-1の合成) 2- (4-フルオロフェニ ル) ーピリジン 1、77g、トリスアセチルアセトナ トイリジウム(III) O、5gおよびグリセロール 30m1を混合し、窒素気流下、200℃で4時間攪料 した。室温まで冷却した後、メタノール 200mlを 加え、析出している個体を譲引した。シリカゲルカラム クロマトグラフィー (クロロホルム) で特報し、淡黄色 闘体 O. 5gを得た。NMRを測定したところ、得ら 【0074】 舶記保護腸の材料としては、水分や酸薬等 30 れた化合物は化合物例K-1であることが嫌認された。 得られた化合物例K-1について、酸素脱気ド、りん光 量子収率を測定したところ(トルエン熔媒、5、0×1 0 mo1/L) 90%であった。また、りん光の発光 極大波長 2 m a x は 4 7 7 n m であった。

[0077] [1817]

## [0078] [合成例2]

(化合物例K-3の合成) 2-(2, 4-ジフルオロフ エニル) ービリジン 3.0g、トリスアセチルアセト ナトイリジウム (III) 1、3g、およびグリセロール

拌した。室温に冷却した後、メタノール200mlを加 え、析出している簡体を識別した。シリカゲルカラムク ロマトグラフィー (クロロホルム) で精製し、淡黄色園 体 O. 8gを得た。NMRを測定したところ、得られ 50m 1を混合し、容素領流下、200℃で4時間樹 50 た化合物は化合物例に一3であることが確認された。穏 られた化台物例K-3について、酸素脱気下、りん光量 予収率を測定したところ(トルエン溶媒、5.0×10 \*大波長 l m s x は 4 7 0 n m であった。 【 0 0 7 9 】

(15)

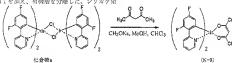
(K-3)

## [0080] [合成例3]

(化合物例K - 9の合成) 化合物 a O. 2g、アセチルアセトン O. O 7m i にクロロホルム 10m1を加え、この階級に、ナトリウムメトキサイドのメタノール溶液 (28質量的)をO. 13m1加え、還進下6時間段手した。電低に冷却した後、クロボルム 50m i、木 50m iを加え、有機限含分離した。シリカゲ系

※ルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム)で精製し、淡黄色周体 0、1gを得た。NMRを制定したところ、得られた化合物は化合物(K~9であることが能器された。

[0081]

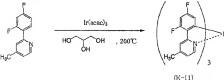


## [0082] [合成例4]

(化合物例K - 11の合成) 2 - (2, 4 - ジフルオロフェニル) - 4 - メチルドリジン 1, 0g, トリスアセチルアセトナトイリジウム (打1) 0.4g, グリセニール 30mlを混合し、窒素気液ド、200℃で 304時間操件した。電温に作用した後、水 200mlを加え、折出している個体を増削した。シリカゲルラン本

★クロマトグラフィー(クロロボルム)で精製し、液黄色 圏体 0、2gを得た。NMRを確定したところ、得られた化合物は化合物例K-11であることが確認された。

[0083] 【化20】



【0084】 [比較例1] 洗浄した  $ITO基板を蒸着装置的に体輸し、<math>\alpha$ -NPD (N, N' ージマェルーN、N' ージ ( $\alpha$ -ナフチル) ーベンジンン 240 n 無奈春し、そ少上に、下記に示す化合物Aおよび化合物 B を(護康比 10:1) の比率で24 n m 共務者し、さらにその上に、化合物Eを24 n m 共務者し、有機轉級を形成した。この有機轉級上にバクーニングしたマスク(発売面積が4 m m × 5 m m となるマスク)を設置し、經常装置内で・グオシウム:銀=10:1 850 n m 共 50

蒸着した後、銀50 n mを蒸着し、4機Eし基子を作製した。前、化合物Bについて、化合物例に一1と同一条 件下でりん光量子収率を測定したところ、りん光量子収率は70%であり、りん光の変光極大数長2 m a x は507 n m であった。 100851

[#21]

· rta w

[0086] [他22]

(Applied Physics Letters vol. 75. Not, 5 July 199912 8200)

【0088】 [比較網2] 比較網1において、化合物B の代わりに下部に下す化合物Cを用い、比較例1と同様に有機で1条字を作製し、評価した。その結果、発光観人波炎人maxが505nm、C1E色度値(x, y) 40 (0.27, 0.57)である緑色発光が得られ、外部様子物学は3、3等であった。

[0089] [#23]

【0090】比較例1および2の結果から明らか今様 に、公知のオルトメタル化イリジウム錯体を含有する有

[0092] [化24]

[0093] [実施例1] 比較例 において、 化合物 B の代わりに化合物例に 1を使用し、比較例 1と間線に 有機 E L 菓子を情報し、 評価した。その結果、 死光微大 波長 2 m s x x 4 8 6 n m、 C I E 色度値 (x, y) = (0、18、0、49) である青色発光が得られ、 外部 居子始線は 5 % 9 でかる青色発光が得られ、外部 居子始線は 5 % 9 % かったり

【0094】[実施偶2] 比較例:において、化合物 B の代わりに化合物例に一は使用し、化合物の代わりに化合物のにあい。 比較例:と同様に有様已,其子を作製し、評価した。その結果、発光極大改長人加 a x が 4 8 7 nm、 C 1 E 色度値 (x, y) = {0.22,0.53) である青色発光が得られ、外部最子物率は10.5%であった。

[0095] [(£25]

(17)

の上に化合物例K-1および上記化合物Dを (質量比 1.17) の比率で36 n m共蒸落し、さらにその上 に、上記化台物Gを36nm基著し、有機維膜を形成し た。この有機薄膜上にパターニングしたマスク(発光面 種が4mm/5mmとなるマスク)を設置し、基着装置 内でフッ化リチウムを3nm蒸着した後、アルミニウム を40 n m蒸寄し、有機EL案子を作製した。その結 果、毫光極大波形 Amaxが 485 nm. CIE 年序館 (x, y) == (0, 19, 0, 51) である青色発光が 器られ、外部量子効率は19,1%であった。

100971 【化26】

【0098】「実施例4】実施例3において、化合物例 K-1の代わりに化合物例K-3を用い、事編例3と間 様に有機EL素子を作製し、評価した。その結果、発光\* \* 極大波長 l m a x が 4 7 3 n m、C i E 色度値 (x. y) = (0, 15, 0, 37) の青色発光が得られ、 外部量子効率は12、9%であった。

【0099】 [実施例5] 実施例3において、化合物例 K-1の代わりに化合物傾K-9を用い、実施例3と間 様に有機EL素子を作製し、評価した。その結果、発光 極大波提入ms x が480 nm. CIE色度質 (v.

v) = (0, 20, 0, 52) の資色発光が得られ、外 部量子効率は11、4%であった。

10 【0100】開様に、本発明の化合物を含有するEL素 子を作製・評価することにより、高効率青色発光EL系 子が作製できる。また、非典役系高分子(例えば、ポリ ビニルカルバブール)、其役系高分子(例えばポリフル オレン系化合物) などを含育する塗布型の高効率者色発 光素子も作製できる。

[0101]

【発明の効果】以上、説明した様に、本発明の発光素子 は、従来の青色発光素子と比較して、高い効率での青色 発光が可能であり、表示素子として用いた場合に、消費

20 億力を大幅に下げることができるとともに、大面積化お よび長時間使用が可能である。また、本発明の青色発光 素子を基本とし、赤~橙色発光材料、赤~橙色発光素子 を組み合わせることにより、高効率白色発光素子も作製 できる。また、本発明によれば、高効率に青色発光する イリジウム蟾体を提供することができる。

#### フロントページの縮き

(72) 举明者 寅下 路介

神奈川県南足柄市中沼210番地 當土写廊

フイルム株式会社内

(72) 鉴明者 離村 香俊

神奈川県南足標市中福210番地 宮士写真

フイルム株式会社内

(72) 発用者 岡田 久

神奈川県南足柄市中和210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(79) 從明者 二島 聯之

神奈川県南足柄市中沼210番地 湖土写真 フイルム株式会社内

(72) 举明者 邱 紫騰

神奈川県南足柄市中沼210番地 寡士写真 フイルム株式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB04 AB05 AB13

BROS CAGI CAGS CROJ BAGO

DB03 EB00 FA01

4C055 AA01 BA02 BA08 BA13 BB14 CAO1 DA01

1H0S0 AA01 AA03 AB92 WB11 W813

WB14 WB21

```
【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第7部門第2区分
[登行日] 平成18年6月1日(2006.6.1)
[公開番号]特牌2002-117978(P2002-117978A)
[公開日] 平成14年4月19日(2002.4.19)
【出願書号】特願2001-189539(P2001-189539)
【圆簖特許分额】
 HOIL 51/50
                (2006, 01)
  C 0 7 D 213/61
                (2006.01)
  C O 9 K 11/06
                (2006, 01)
  H O 5 B 33/10
                 (2006, 01)
  C 0 7 F 15/00
                (2006, 01)
[ [ ] ]
  H O 5 B 33/14
                    13
  C 0 7 D 213/61
  C 0 9 K 11/06
               6 6 0
 H O 5 B 33/10
 C 0 7 F 15/00
                   E
[手統補正審]
【提出日】平成18年4月10日(2006, 4.10)
[手維納正1]
1 補正対象書類名1 明細書
【補正対象項目名】0096
【辅正方法】変更
「補正の内容」
100961
[実施例3]
```